

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, выпуск 6

| | |
|--|-----|
| XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2018" (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8- 12 октября 2018 г. | |
| Асач А.В., Исаченко Г.Н., Новотельнова А.В., Фомин В.Е., Самусевич К.Л., Тхоржевский И.Л. XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2018" (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8-12 октября 2018 г. Влияние неидеальности геометрической формы образца на неопределенность измерений теплопроводности методом лазерной вспышки | 731 |
| Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Крушельницкий А.Н., Суслов А.В., Суслов М.В. Особенности проявления квантового размерного эффекта в явлениях переноса в тонких пленках висмута на подложках из слюды | 736 |
| Коробейников И.В., Морозова Н.В., Лукьянова Л.Н., Усов О.А., Овсянников С.В. Фактор мощности твердых растворов на основе теллурида висмута в области топологических фазовых переходов при высоких давлениях | 741 |
| Овчинников А.Ю., Константинов П.П., Пшенай-Северин Д.А., Бурков А.Т. Гальваномагнитные свойства моносилцида кобальта и сплавов на его основе | 746 |
| Шабалдин А.А., Константинов П.П., Курдюков Д.А., Лукьянова Л.Н., Самунин А.Ю., Стовпяга Е.Ю., Бурков А.Т. Термоэлектрические свойства нанокompозитного $\text{Bi}_{0.45}\text{Sb}_{1.55}\text{Te}_{2.985}$ с микрочастицами SiO_2 | 751 |
| Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Ильин А.С., Осипков А.С., Григорьянц А.Г. Радиационные термоэлементы на основе теллурида висмута, получаемые методом импульсного лазерного осаждения | 756 |
| Сидоренко Н.А., Дашевский З.М. Криогенный термоэлектрический модуль для рабочего интервала температур ниже 90 К | 761 |
| Сидоров А.В., Грабов В.М., Зайцев А.А., Кузнецов Д.В. Термоэлектрические и термоэлектрокинетические явления в коллоидных растворах | 765 |
| Соломкин Ф.Ю., Орехов А.С., Новиков С.В., Архарова Н.А., Исаченко Г.Н., Зайцева Н.В., Шаренкова Н.В., Самунин А.Ю., Клечковская В.В., Бурков А.Т. Структура и термоэлектрические свойства CoSi, полученного из пересыщенного раствора-расплава в Sn | 770 |
| Степанов Н.П., Гильфанов А.К., Трубицына Е.Н. Корреляция оптических и магнитных свойств кристаллов $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ | 774 |
| Таранова А.И., Новицкий А.П., Воронин А.И., Таскаев С.В., Ховайло В.В. Влияние легирования ванадием на термоэлектрические свойства сплавов Гейслера $\text{Fe}_2\text{Ti}_{1-x}\text{V}_x\text{Sn}$ | 777 |
| Тукмакова А.С., Самусевич К.Л., Новотельнова А.В., Тхоржевский И.Л., Макарова Е.С. Моделирование процесса усадки термоэлектриков при искровом плазменном спекании на примере Ge-Si | 781 |
| Кузнецова В.С., Новиков С.В., Ниченаметла Ч.К., Кальво И., Вагнер-Ритц М. Структура и термоэлектрические свойства пленочных композитов на основе CoSi | 784 |
| Публикация материалов Конференции завершена. | |
| Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия) | |
| Печников А.И., Степанов С.И., Чикиряка А.В., Щеглов М.П., Одноблюдов М.А., Николаев В.И. Толстые слои $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ на сапфировых подложках, полученные методом хлоридной эпитаксии | 789 |
| Электронные свойства полупроводников | |
| Морозова Н.К., Мирошникова И.Н., Галстян В.Г. Анализ оптических свойств пластически деформированного ZnS(O) с привлечением теории антипересекающихся зон | 793 |
| Ярыкин Н.А., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Лодыгин А.Н., Астров Ю.А., Абросимов Н.В., Weber J. Исследование энергетического спектра кристаллов Si:Mg методом DLTS | 799 |

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Ситников С.В., Родякина Е.Е., Латышев А.В.

Влияние электромиграции на зарождение вакансионных островков на поверхности Si(100) при сублимации

805

Кожемяко А.В., Евсеев А.П., Балакшин Ю.В., Шемухин А.А.

Особенности дефектообразования в наноструктурированном кремнии при ионном облучении

810

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Соболева О.С., Юферев В.С., Головин В.С., Гаврина П.С., Романович Д.Н., Мирошников И.В., Пихтин Н.А.

Особенности транспорта носителей заряда в структурах $n^+-n^0-n^+$ с гетеропереходом GaAs/AlGaAs при сверхвысоких плотностях тока

816

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Дроздов К.А., Крылов И.В., Чижов А.С., Румянцева М.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.

Оптически индуцированный зарядовый обмен в композитных структурах на основе ZnO с внедренными нанокристаллами CsPbBr₃

824

Нифтиев Н.Н.

Правила Урбаха в монокристаллах MnGa₂Se₄ при оптических поглощениях

829

Физика полупроводниковых приборов

Романов В.В., Белых И.А., Иванов Э.В., Алексеев П.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П.

Светодиоды на основе асимметричной двойной гетероструктуры InAs/InAsSb/InAsSbP для детектирования CO₂ ($\lambda=4.3$ мкм) и CO ($\lambda=4.7$ мкм)

832

Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.

Особенности формирования замкнутых модовых структур в прямоугольных резонаторах на основе гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs для мощных полупроводниковых лазеров

839

Банщиков А.Г., Илларионов Ю.Ю., Векслер М.И., Wachter S., Соколов Н.С.

Характер изменения обратного тока в туннельных МДП-диодах с фторидом кальция на Si(111) при создании дополнительного оксидного слоя

844

Шашкина А.С., Ханин С.Д.

Имитационный подход к моделированию лавинного пробоя p-n-перехода

850

Калинина Е.В., Виолина Г.Н., Никитина И.П., Яговкина М.А., Иванова Е.В., Забродский В.В.

Облучение протонами 4H-SiC фотоприемников с барьером Шоттки

856

Иванов П.А., Кудояров М.Ф., Потапов А.С., Самсонова Т.П.

Коррекция характеристик обратного восстановления высоковольтных инжекционных 4H-SiC диодов с помощью протонного облучения

862

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Маскаева Л.Н., Федорова Е.А., Марков В.Ф., Кузнецов М.В., Липина О.А.

Состав, структура, полупроводниковые свойства химически осажденных пленок SnSe

865